科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年6月5日現在

機関番号:11201
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2009~2011
課題番号:21560436
研究課題名(和文)
画像原子磁力計のための MEMS サブミリセルの作製と評価
研究課題名(英文)
Production and evaluation of the MEMS submillimeters cell for imaging atomic
magnetometers
研究代表者
大坊 真洋 (DAIBO MASAHIRO)
岩手大学・工学部・准教授
研究者番号:20344616

## 研究成果の概要(和文):

アルカリ金属原子に円偏光のレーザー光を照射し、外部から磁場を加えると電子が歳差運動する。この光ポンピング原子磁力計は、偏光の変化として磁場を超高感度に検出することができる。従来の磁力計はガラスによる真空デバイスなので、小型化できなかった。我々はマスクを通してのカリウムの蒸着、ガラス搬送、シリコンとガラスの陽極接合を真空中で行う装置を開発し、穴径 700 µm、深さ 500 µm のセルアレイ(5×5 個)を製作した。

## 研究成果の概要(英文):

When a circularly-polarized laser beam and magnetic field are applied to an alkali metal atom, the electron performs precession. This optical pumping atomic magnetometer can detect a magnetic field in very high sensitivity as a change of the polarization. Because the conventional magnetometer was a vacuum device with the blown glass, it was unsuitable for miniaturization. We developed the apparatus which performed vapor deposition of potassium through a mask, glass conveyance, the anodic bonding the silicon and the glass in vacuum. We finally produced 5 x 5 cell array whose hole diameter is 700  $\mu$  m and 500  $\mu$  m in depth.

			(並領平匹 1)
	直接経費	間接経費	合 計
2009年度	2,000,000	600,000	2,600,000
2010年度	1, 100, 000	330,000	1, 430, 000
2011年度	500,000	150,000	650,000
総計	3,600,000	1, 080, 000	4, 680, 000

交付決定額

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学・計測工学 キーワード:計測システム、センシングデバイス

1. 研究開始当初の背景

今後直面することが確実な超高齢社会に 向けて生体磁場計測による疾患の早期発見、 また持続的省資源社会における構造体イン フラの非破壊検査において、磁気センサーの 果たすべき役割はますます大きくなってい る。特に、地磁気という大きな磁場が存在す る地上で、高感度で安定な磁気測定ができる システムが必要とされている。

(令妬畄位・田)

これまで、微弱磁場計測は SQUID (超伝 導量子干渉素子)の独壇場であった。しかし、 2003 年にプリンストン大学の Romalis らが 原子磁力計で 1 fT 以下の磁気感度を実現し たのを契機に、原子磁力計が注目されている。 現在は、核磁気共鳴、脳磁計測などの応用研 究も始まっており SQUID に代わる磁気セン サーとして研究が活発化してきている。様々 な用途に合った磁場検出システムを構築す る段階になってきた。

元来、磁場は対象物に接触しなくても、少 し離れたところから計測することができる ので、危険性や汚染防止のために接触できな い対象物や、表面が絶縁体でカバーされて電 気的なアクセスができないものでも内部の 電気的状態を計測することができ、非常に重 要な計測手段である。原子磁力計を使えば、 超伝導デバイスでは必須であった極低温環 境が不要になり、小型軽量化、低コストに好 適である。さらに原子由来の正確な絶対値計 測が可能になり、静電破壊、温度サイクル、 高湿度環境にも強い高い信頼性を有するシ ステムが実現できる。

我々は工業的・産業的に現実的な簡易磁気 シールド環境下で大型のセルを使用して 300fTの感度を実現してきた。次のステップ としてやるべきことは、ガスセルをどこまで 小さくできるか? 画像計測するために、ど のようにして微小ガスセルのアレイを作製 できるか?を実験的に確かめることである。 化学的に反応性の極めて高いアルカリ金属 を微少なセルに封入する方法を確立し、微弱 磁場の画像計測を実現する基本デバイスを 開発する。

2. 研究の目的

 (1)小型セルの作製方法の確立
 ② 容積 1000 mm<sup>3</sup>以下のミリメートルから センチメートルサイズのセルの製作
 ② 容積 500×500×500 µ m<sup>3</sup>、MEMS 技術 を利用した超小型セルの作製方法

- ・ ディープ RIE のマスキング
- シリコンの基板貫通 RIE エッチング
- エッチストッパの方法

(2) MEMS 超小型セルへのアルカリ金属の封入装置の開発

- ・ 金属カリウムのソース源の実現方法
- 反応性の高いアルカリ金属のセルへの移送方法
- セルの中央部のみにアルカリ金属を付着 させる方法
- ガラスをシリコン表面に接触させる方法
- シリコンとガラスのアノーディック・ボ ンディング
- (3) 温度計測・加熱の光化

セルを小型化するとビームに相互作用す る原子数が減少するので感度は低下する。同 じ感度を維持するには、セル温度を上昇させ なければならない。セル温度を上昇させるに は、支持体との接触断面積を小さくして、伝 導による熱損失も最小限にとどめなければ ならない。従来は、高温にするために外部ヒ ーターからの熱風により加熱(250℃)して いるが、この方法では小型化には向いておら ず、高温にするのは困難である。他の方法と しては、セル表面に ITO 膜を付着させ、ジュ ール加熱する方法も行われているが、加熱中 は磁場が発生するので、信号を測定できない。 リード線を伝わる熱損失や、金属材料がセル 近傍に存在することによる渦電流発生の問 題もあり、好ましくない。

そこで本研究では、半導体レーザーによる 加熱を行う。この方法を使えば、温風を閉じ 込めるエンクロージャが不要となり、風によ る振動も皆無で、金属の接触もないため、理 想的な加熱方法となる。

また温度計測を現在は熱電対で行ってい るが、セル近傍に磁場を乱す金属が存在する ことになり、また接触熱損失によるセル温度 の不均一性が懸念されるので、赤外線放射を 原理とした非接触温度計測を行う。これによ り完全な光化を達成する。

ミリメートルクラスの小型セルで原子磁 力計を作成した報告は、国内では全くない。 また、アルカリ金属は反応性が高く、大気中 での加工ができない材料である。これを MEMS 技術により小型化する取り組みは原 子磁力計ではまだほとんど報告がなく、多画 素アレイを作成しようとする試みは世界的 にも例がなく新規性が高い。安定に微小セル を作製するプロセスを構築することは工学 的には極めて重要であり、産業化、低コスト 化、普及にむけての基盤技術となる。

この技術が確立されれば、心臓疾患の早期 発見・スクリーニングやインフラ構造体の安 全運用に耐えうる高感度磁気画像センサー となるので、医療分野や産業界へ貢献可能で あり、意義は深い。

研究の方法

(1) 小型セルの作製方法の確立

 ミリメートルクラスのガラスセル(ミリ セル)の作製

金型による型押しにより作成可能なミリメ ートル程度の大きさのガラスセルを作製す る。

 MEMS 技術を利用した超小型セルの作 製方法

ICP-RIE 装置による単結晶シリコン基板の エッチング条件出しを行う。厚さ 300-500µm の単結晶シリコンウェハーを貫通し、 壁面ができるだけ平滑となる条件を探る。

RIEのマスクには粘度の高い KMPR-1010を 使用し膜厚を 10 μ m 程度にする。

エッチストッパには熱酸化 SiO<sub>2</sub> 膜を使用する。

(2) MEMS 超小型セルへのアルカリ金属の封入装置の開発

(2-1)金属カリウムのソース源には、①金属カ

リウムアンプルから直接的に蒸着する方法、 ②オイル中保存の金属カリウムブロックを グローブボックス中でキシレンにより洗浄 して蒸着する方法、③BaN<sub>6</sub>と KClを 300℃ 程度の温度で還元反応させて、金属カリウム 原子を生成する方法、④真空中のアジ化カリ ウム KN<sub>3</sub>に紫外線を照射して分解する方法、 ⑤アルカリメタルディスペンサにより蒸着 をする各方法を試みる。

(2-2) アノーディックボンディングをするためのチャンバー内に、加圧電極、バッファガス調圧機構、蒸着ガンを組み込む。さらにチャンバー内で張り合わせる2枚の基板を重ね合わせるマニュピュレータ機能も実装する。

(2-3) アノーディックボンディングの最適条 件

アルカリ金属の融点は低いため、400℃程度 の基板温度を必要とする通常のアノーディ ックボンディングでは、アルカリ金属が蒸発 してしまう。電圧、印加時間、基板温度の各 パラメータの最適条件を探る。

(3) 温度計測・加熱の光化

LD アレイからバンドルファイバで取り出した 20W クラスの近赤外線によりセルの一部 を構成しているシリコンを加熱する。温度は 遠赤外線でモニタリングし、レーザーパワーを PID 制御によりフィードバックする。

(4) ミリセル、MEMS セルの評価

温度、バッファ圧力、レーザー強度、信号周 波数、偏光などをパラメータとして最適動作 条件の評価を行う。

4. 研究成果

(1) 小型セルの作製方法の確立

①ミリセルの製作

高温金型による型押しガラスセル(容積 9 ×8×9 mm<sup>3</sup>、ミリセル)を作製した。この サイズでは3kHzで1pTの感度が再現性よ く得られている。なお、楕円偏光を使う方法 改良したためシングルビーム化が可能にな り、光学平面は2面で良くなったため、研磨 ガラスの張り合わせセルでも低コストに使 用可能となった。

 MEMS 技術を利用した超小型セルの作 製方法

作成フローを図1に示す。ICP-RIE 装置に よる単結晶シリコン基板のエッチング条件 を調べ、厚さ500 $\mu$ mの単結晶シリコンウェ ハーを貫通し、直径700 $\mu$ mの25個のキャ ビティーを作製できた。同様にメタルマスク もシリコンを RIE 加工することによって作 製した。

体積を増大させるために穴径を 1600 µ m に 拡大したセル(4x4 個穴)も作成した。

(2) MEMS 超小型セルへのアルカリ金属の封入装置の開発

真空中でカリウムを MEMS セルに一括導入・封止する装置(図2)を製作した。



図1 MEMS セルの作成フロー



図2 カリウム導入・封止装置



図3 側壁へのコンタクトプローブ

この装置には次のような機能を有している。

①メタルマスクと、カリウムが入るキャビティーを、50µmの精度で位置合わせする。アフォーカル系レンズでメタルマスクの穴を通して見えるセルの位置を合わせることができる。

②金属カリウムを溶融蒸発または還元蒸着 させて、ノズルからガラスマスクを通してキ ャビティー内に蒸着させる蒸着ガンを備え ている。

③バッファーガスを導入し、圧力を調整できる。

④カリウムをセルキャビティー底部に蒸着
 後、アノーディックボンディング部へコンピュータ制御で正確に移動させる。

⑤パイレックスガラスをシリコン基板に重 ね合わせ、アノードおよびカソード電極を2 層基板試料にコンピュータ制御で接触させ、 再現性のある圧力を加える。

⑥シリコンを2枚のガラスで挟みこむよう に封止するために、2枚目のガラスのボンデ ィングの時にはシリコンの側壁から電極の コンタクトをとれるように薄い電極を備えている(図3)

⑦セラミックヒーターと温度を測定する熱 電対から構成され基板を設定温度に加熱す ることができる。

⑧最大3 kV の高電圧を印加し、アノーディ ックボンディングを行う。



図 4 アノーディックボンディングの電流 変化 基板温度 250℃、印加電圧 3 kV

次に MEMS 技術によるマイクロメートル サイズのセルを作製するため不可欠なアノ ーディックボンディング条件を調べた。シリ コンとパイレックスガラスが対象である。シ リコンは RCA1, RCA2 の洗浄を順に行った。 パイレックスガラスはアセトンの超音波洗 浄を行った。

基板温度 300℃、3 kV の場合はピークで 700 µ A程度の電流が流れ 90 秒程度でボンデ ィングが完了した。250℃、2.5 kV の場合は、 ピークで 50 µ A 程度の電流が流れ、500 秒 程度で完了まで要する。

一方、カリウムをセル内に蒸着後のアノー ディックボンディングは様相が全く異なる。 カリウムの融点は、63℃と低温であるため、 アノーディックボンディングの時の高温に より蒸発が懸念された。そこで、できるだけ 低温でボンディングがなされるように、室温 から3 kV を印加しながら基板温度を上昇さ せた。この場合、170℃以上で反応電流が急 増し接合隙間の干渉縞により、接合している ことが観察された。しかしさらに温度が上昇 すると電流が振動的に増減し、250℃以上で は電流値はピークよりも下がった値で飽和 した。ボンディング電極から遠い場所では最 終的に接合しなかった。これはシリコンとガ ラスの熱膨張係数の違いにより、一時的な接 合と剥離を繰り返しているためと考えられ る。そこで、250℃に温度を上昇させてから、 高電圧を印加する実験を行った。図4にその 時のアノーディックボンディングの電流変 化を示す。この場合は温度が一定なので、電 流はほぼ単調に減少している。

シリコンのチップは 10 x 10 mm で切り出 しているため、周辺部にハンドリングや洗浄 による損傷があることと、アノーディックボ ンディングの針電極をチップ中央部に1本 だけ立てているため、チップ全面(25 個セル) での均一な接合は難しいが、少なくとも中央 部では封止された。界面にナイフエッジを入 れることによる剥離実験でも、界面から剥離 されることはなく、母材が割れた。

さらにアルカリ金属存在下での AD の不安 定性を調べるために、融点が 28℃と低い Cs でも同様の封止実験を行った。K では接合し たが、Cs では全く接合しなかった。金属状態 でのアルカリ金属蒸気が Si 表面に付着する ことにより、AD が阻害されていると考えら れる。蒸着後のあの-ディックボンディング は K には適用できたが、本質的に界面の不安 定要素を含んでおり、全てのアルカリ金属に 適用できるとは言えない。

図5に上記一連のプロセスにより作成した MEMS セルの外観を示す。25 個のセルはバッチ処理で一括して作成しており、従来の手作業で一つ一つ製作する方法とは本質的に異なる。また、体積も最小であり、アレイ状に製作した報告はこれまでない。



図5 MEMS セルの外観.5×5個の穴が 空いた Si チップがパイレックスガラスによ り上下から封止されている.

## (3) 光加熱・計測による全光化

セルの加熱には、まず 15 W 程度の LD アレ イからバンドルファイバーで導光し、SiC プ レートに光吸収させて昇温させた。SiC プレ ートとガラスセルは耐熱性のコーキング剤 で熱接触させた。全体をアラミド繊維で吊る すことにより固定による熱損失が最小限に なるようにした。温度は赤外線放射をモニタ リングし、加熱用の LD アレイに PID 制御に よりフィードバックして安定化させた。これ により加熱、測温、ポンピング、偏光計測を 全て光で行うことができるシステムを構築 した。

## (4) MEMS セルの評価

MEMS セルの後方にピンホールを置き、特定のセルを透過した光の吸収スペクトルを、 レーザー波長を掃引して計測した。図6に吸 収スペクトルの結果を示す。室温時には封入 されたカリウムの蒸気が少ないために吸収 は現れないが、高温にしたセルには D1 波長 に対応した 770.12 nm 付近に吸収が現れている. 数週間の時間を置いた後でも吸収があ



図6 MEMS セルの吸収スペクトル.

り、カリウムの封止はできていることが確認 できた。

このような微小なセルの場合は、従来のようにプローブ光とポンプ光を独立に直交し て導入することは極めて困難である。そこで 我々は楕円偏光のシングルビームで測定す る方法を開発した。楕円率と波長を最適化す ることにより、ポンピングとプロービングを 同時に実現した。体積が 1,000 mm<sup>3</sup>のセルを 使用して、3 kHz で 300 fT の磁気信号を検出 できた。

MEMS セルでは、カリウムの封止は確認 できたが有効な磁気感度は得られていない。 この原因として、RIEの時に側壁に残ってい るハロゲンの問題があり、現在はそれを除去 するプロセスを実施している。また、バッフ ァガスを導入すると、通常よりも高い電圧で のアノーディックボンディングのため、異常 放電が起こり、バッファガスの適正な導入も 容易ではない。これらのことから、セル内で のカリウムの直接還元により、金属カリウム とバッファガスを同時封入する方法を検討 中である。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計10件)

 太田越寿継、大坊真洋、楕円偏光原子磁 力計の楕円率依存性、平成24年度東北地区 若手研究者研究発表会、2012.3.9、仙台高等 専門学校(宮城県)

② 野崎孝弘,加賀谷祐輔,千葉寿,大坊真 <u>洋</u>、両面アノーティックホンティンクによる アレイ型マイクロセルの開発、計測自動制御 学会東北支部第264回研究集会、2011.3.11、 東北文化学園大学(宮城県)

③ 加賀谷祐輔,野崎孝弘,<u>大坊真洋</u>、MEMS 加工シリコンセルによる原子磁力計の研究、 応用物理学会東北支部第65回学術講演会講 演予稿集、2010.11.26、東北大学(宮城県) ④ 佐々木 勝平,太田越寿継,大坊真洋、全 光制御型原子磁力計による非接触半導体検 查、第71回応用物理学会学術講演会、 2010.9.14、長崎大学(長崎県) ⑤ 野崎孝弘,加賀谷祐輔,<u>大坊真洋</u>、MEMS によるマイクロ原子磁力計セルの開発、平成 22 年度電気関係学会東北支部連合大会、 2010.8.27、八戸工業大学(青森県) ⑥ 佐々木勝平,太田越寿継,大坊真洋、原 子磁力計による非接触半導体検査、平成 22 年度電気関係学会東北支部連合大会、 2010.8.26、八戸工業大学(青森県) ⑦ 太田越寿継, 佐々木勝平, 大坊真洋、カ リウム光ポンピング原子磁力計のための偏 光度検出システムの開発、平成 22 年度電気 関係学会東北支部連合大会、2010.8.26、八戸 工業大学 (青森県) ⑧ 佐々木勝平,大坊真洋、全光型原子磁力 計、第 70 回応用物理学会学術講演会予稿集、 9p-A-1、2009.9.9、富山大学(富山県) ⑨ 佐々木勝平,大坊真洋、レーザー加熱に より温度制御された原子磁力計、計測自動制 御学会東北支部 45 周年記念学術講演会、 2009.9.7、岩手大学(岩手県) ⑩ 佐々木勝平,大坊真洋、全光制御原子磁 力計の構築と磁場感度評価、平成 21 年度電 気関係学会東北支部連合大会、2009.8.20、東 北文化学園大学(宮城県)

6.研究組織
(1)研究代表者
大坊 真洋(DAIBO MASAHIRO)
岩手大学・工学部・准教授
研究者番号:20344616